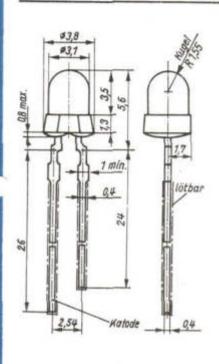


Infrarotemitterdiode **VQ 123**



Die VQ 123 ist eine GaAs-Infrarotemitterdiode Dieses Bauelement wurde vorzugsweise als in einer rauchfarbenen 3 mm Allplast-Linsen- Strahlungsquelle im nahen Infrarotbereich für Verkappung. Die Diode weist einen hohen Strah- Anwendungen in der Unterhaltungselektronik, lungsfluß auf und ist für Impulsbetrieb geeig- Spielwarenindustrie und in der Industrieeleknet. Der Emissionsbereich ist an den spektra- tronik konzipiert. len Empfindlichkeitsbereich von Si-Fotoempfängern angepaßt.



Masse: 0,12 g Standard: TGL 55100

Kenngrößen bei ♣a = 25 °C					
DurchlaBgleichstrom		min.	typ.	max.	
bei Ip = 50 mA	Up	-	1,3	1,5	v
bei Ip = 100 mA	UF	-	1,4	1.7	V
Strahlungsleistung 1)					
bei Ip = 50 mA VQ 123 A	$g_{\rm e}$	1,6	_	3,5	mW
bei $I_p = 50 \text{ mA} \text{ VQ 123 B}$	\$	2,3	-	4,0	mW
bei $I_F = 50 \text{ mA} \text{ VQ 123 C}$	ø	2,6		-	mW
Sperrgleichstrom					
bei $U_{R} = 3 \text{ V}$	IR	-	-	10	JA
Öffnungswinkel					
bei $I_{\mathbf{F}} = 50 \text{ mA}$	0	50	-	-	0
Wellenlänge des Maximums					
der spektralen Emission					
bei $I_{\mathbf{F}} = 50 \text{ mA}$	Amax	900	940	980	${\rm nm}$
Spektrale Strahlungs-		*			
bandbreite	A20,5	~	-	75	nn
Schaltzeiten					
bei I _{FRM} = 50 mA					
Impulsanstiegszeit	tr	-	-	2	us
Impulsabfallzeit	to	_	-	2	us





veb werk für fernsehelektronik berlin im veb kombinat mikroelektronik

DDR - 1160 Berlin, Ostendstraße Telefon: 6 38 30, Telex: 112 007

elektronik export import

Volkseigener Außenhandelsbetrieb der Deutschen Demokratischen Republik DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6-Telex: BLN 114721 elei